

سلولهای خورشیدی با فناوری چاه کوانتومی

تیرماه ۱۴۰۱

دانشگاه قم

استاد راهنما: دکتر جعفر محمودی

دانشجویان: زهرا معدنکن



مقدمه

امروزه دنیا در حال گذار از انرژی تجدیدناپذیر به سمت انرژیهای نو میباشد. کشور ما ایران نیز از این قاعده نمی تواند مستثنی باشد؛ تغییرات آب و هوایی، اتمام ذخایر نفتی تا ۱۵۰سال آینده و سما را از این گذار ناگریز کرده. از طرفی پیشرفت تکنولوژی و کاربرد روز افزون انرژی پاک خورشیدی، توجه جهانی را به این منبع انرژ معطوف ساخته است.

در حال حاضر سلولهای خورشیدی چند اتصالی V-III بالاترین راندمان را بین فناوریهای مختلف سلولهای خورشیدی دارند. اخیرا تکنیکهای بسیاری منجر به پیشرفت کلی راندمان سلولهای خورشیدی چند اتصالی خورشیدی دارند. اخیرا تکنیکهای بسیاری منجر به پیشرفت کلی راندمان سلولهای خورشیدی میبخشند، شامل V-III با سه تا شش اتصال شده است. اما دستگاههایی با اتصالات زیاد به ساختار پیچیدگی میبخشند، شامل مواد چالش برانگیز را میشوند و میتوانند به تغییرات در طیف بسیار حساس شوند. به شکل قابل توجهی، افزایش بهرهوری با افزودن اتصالات در دستگاههایی با بیش از سه اتصال به دلیل چالشهای مواد عملی مشکل ساز می شود.

در این طرح، پیشنهاد ما ساخت دستگاههایی سه اتصالی است که کارایی بالاتری نسبت به دستگاههای شش اتصالی قدیمی دارند. این اتفاق با بهبود طراحی ترکیب فاصله باند میسر است. چاههای کوانتومی(QWS) می توانیم می توانید برای مهندسی فاصله باند یک ماده مورد استفاده قرار گیرند لذا با استفاده از QWها می توانیم اثربخشی شکاف باند را افزایش دهیم. سلول های خورشیدی چند پیوندی V-III سه اتصالی معمولاً از GaAs به عنوان سلول میانی به دلیل کیفیت مواد تقریباً عالی آن استفاده می کنند، علی رغم اینکه فاصله باند آن بالاتر از حد مطلوب برای طیف جهانی است. در اینجا، شکاف باند GaAs را با استفاده از سلولهای خورشیدی چاه کوانتومی(QW) ضخیم GalnAs/GaAsP با ولتاژ و جذب عالی اصلاح می شود. این QWها با کارایی بالا در یک دستگاه چند اتصالی دگرگونی معکوس سه اتصالی متشکل از سلول بالایی GalnP، سلول میانی چاه کوانتومی GalnAs/GaAsP و سلول پایینی GalnAs در شبکه قرار می گیرند که هرکدام بسیار بهینه شدهاند. در این حالت بازده اتصال سه گانه به ترتیب GalnAs در شبکه قرار می گیرند که هرکدام بسیار بهینه شدهاند. در این حالت بازده اتصال سه گانه به ترتیب Anny و ۲۹۳٪ در طیف جهانی و فضایی می شود که شدهاند. در این حالت بازده اتصالی قدیمی بالاتر است.

عملكرد

جذب کل در سلول خورشیدی چاه کوانتومی GalnAs/GaAsP (QW) به ضخامت و تعداد جاههای کوانتومی بستگی دارد .QWs به عنوان چاههای کوانتومی که از ۳۳٪ GalnAs و ۶۷٪ GaAsP، و QWs با لبه جذب ۱.۳۵ eV تشکیل شده است. در اینجا، سلولهای خورشیدی چاه کوانتومی با کرنش متعادل GalnAs/GaAsP را با استفاده از موانع ناز کتر ۵ نانومتری GaAs.68P.32 با چاههای ۸.۵ نانومتری Ga_{.89}ln_{.11As} طراحی شده است تا جذب افزایش یابد. ضخامتها و ترکیبات، شرایط متعادل کننده کرنش بدست آمده را برآورده می کند و در شکل ۴ نشان داده شده است. تنش متوسط خالص در QWs با اندازه گیری انحنای ویفر با یک پروب نوری در طول رشد تقریباً صفر است. شرایط رشد و توالیها بهمنظور ایجاد سطوح مشترک ناگهانی و تغییرات ضخامت جانبی محدود انتخاب شدند. شکل ۲ ساختار اتصال سه گانه نهایی را نشان می دهد که در آن این MQWها در نظر گرفته شدهاند. ساختار تست تک اتصال با سلول میانی دستگاه سه اتصال یکسان است، با لایههای تماس خارج از لایههای مانع .GalnP به عنوان یک ساختار ناهمگون عقب معکوس استفاده شد، که دارای یک تابش کننده GaAs نوع n سیلیکوندوپ شده ۱ میکرومتری و یک پایه GalnP نوع p با روی دوپ شده ۲.۳ میکرومتر است. جزئیات ساختار MQW در سمت راست شکل ۲ نشان داده شده است. QWs بدون دوشاخه و بین n-GaAs و p-GaInP قرار گرفتهاند، با GaAهای ۵۰ نانومتری بدون لایه در دو طرف که به منظور به حداقل رساندن تاثیر انتشار پتانسیل استفاده شدهاند. تعداد چاههای کوانتومی به طور سیستماتیک از ۲۰۰ تا ۳۰۰ متغیر است که ضخامت لایه چاه GalnAs تجمعی را به ترتیب از ۸۵۰ نانومتر به ۲.۵ میکرومتر افزایش می دهد. دستگاه با ۲۰۰ چاه به دلیل وجود رفلکتور از نظر نوری ضخیم است، در حالی که دستگاه با ۳۰۰چاه بیش از ۲.۵ میکرومتر GalnAs دارد و بنابراین حتی بدون بازتابنده نیز ضخامت نوری خواهد داشت. به طور جالب توجهی، با افزایش تعداد چاهها، یک جابجایی کوچک باند وجود دارد، که نشان دهنده تغییر جزئی موادی است که می تواند به شروع تدریجی ضخامت جانبی یا مدولاسیون ترکیب مربوط باشد. ۳۰۰ QWs جریان ۲.۶mA/cm² را در طیف جهانی و ۳.۵mA/cm² را در طیف فضایی AM دريافت مي كنند.

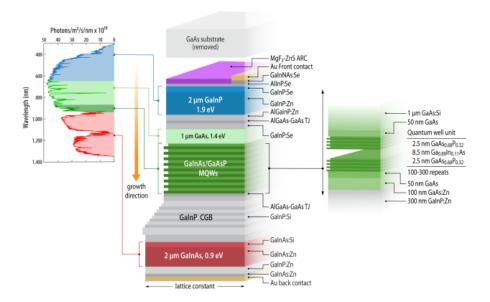


Figure 2. Triple-junction device structure

- (A) Global spectrum, with the portions of the spectrum for the top, middle, and bottom subcells of a triple-junction device highlighted in blue, green, and red, respectively.

 (B) Illustration of the triple-junction IMM structure including MQWs in the middle subcell.
- (C) Expanded illustration of the structure of the MQWs, used in both the triple-junction cell and single junction test structures.

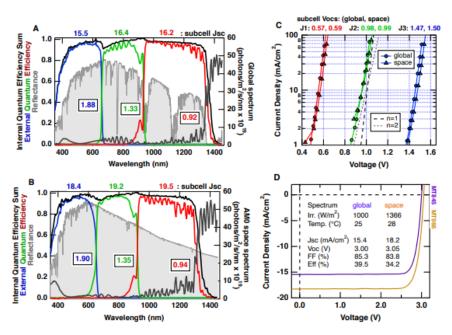


Figure 4. Performance of triple-junction inverted metamorphic devices with quantum wells in the middle cell

(A and B) External quantum efficiency of devices designed for the (A) global or (B) space spectra, overlaid on top of the corresponding spectra. The subcell bandgaps are inside each graph, and the integrated subcell photocurrents are shown on top of each graph.

- (C) Subcell dark J-V curves, determined from electroluminescence measurements. EL spectra are shown in Fig. S7. The voltage of each subcell at the multijunction Jsc is shown for each device on top of the graph.
- (D) Illuminated J-V curves and performance metrics of both devices tested under the appropriate spectra, independently measured by the Cell and Module Performance team at NREL.

كاربرد

سلولهای خورشیدی V-III، برای کاربردهای زمینی مناسب هستند من جمله: وسایل نقلیه هوایی یا خودروها، تقسیم آب فوتوالکتروشیمیایی، تولید هیدروژن و سایر سوختهای خورشیدی، کاربردهای ترموفتوولتائیک مانند ذخیره انرژی، مبدلهای قدرت لیزری، و برای سیستمهای فتوولتائیک متمرکز کننده که در آن نور بر روی نیمههادی متمرکز میشود تا هم کارایی را بیشتر کرده و هم سطح نیمههادی مورد نیاز را کاهش دهد، استفاده میکنند.

این سلول خورشیدی همچنین فناوری غالب برای ماهوارهها و وسایل نقلیه فضایی است، جایی که هزینههای پرتاب بالا، کارایی و جرم را به معیارهای کلیدی تبدیل می کند و محیط تشعشع مستلزم تحمل ذرات با انرژی بالا است. این سلولها به علت جرم کم و ماندگاری به نسبت مناست بیش ترین گزینه ی مورد استفاده در ماهوارههاست.









تصاویری از کاربردهای سلول

منابع

- France, R. Geisz, J. Song, T. Olavarria, W. Young, M. Kibbler, A and Steiner, M." Triple-junction solar cells with 39.5% terrestrial and 34.2% space efficiency enabled by thick quantum well superlattices", Joule, Volume 6, Issue 5p923-1136, Pages 1121-1135, 2022
- https://factnameh.com/fa/fact-checks/2018-08-22-iran-oil-gas-reserves